

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月1日(01.12.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/249889 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 7/40 (2018.01)
B32B 27/00 (2006.01) C09J 201/00 (2006.01)
C09J 7/29 (2018.01) H01L 21/683 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/019982
- (22) 国際出願日: 2022年5月11日(11.05.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-088685 2021年5月26日(26.05.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社 ディスコ (DISCO CORPORATION) [JP/JP]; 〒1438580 東京都大田区大森北二丁目13番11号 Tokyo (JP). デンカ株式会社 (DENKA COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 本池 進悟 (MOTOIKE, Shingo); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 飯塚 一樹 (IIZUKA, Kazuki); 〒1038338 東京都中

央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 中村 将 (NAKAMURA, Masashi); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 蓮見 水貴 (HASUMI, Mizuki); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).

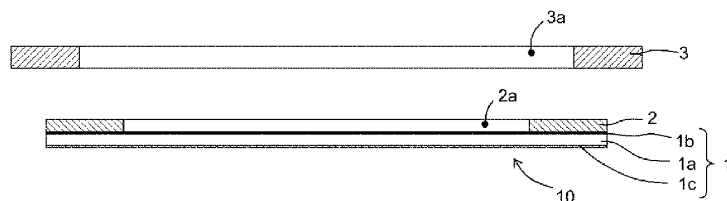
(74) 代理人: S K 特許業務法人, 外 (SK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM et al.); 〒1500012 東京都渋谷区広尾3-12-40 広尾ビル4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

(54) Title: ADHESIVE SHEET FOR BACKGRINDING, SEMICONDUCTOR WAFER MANUFACTURING METHOD, AND SUBSTRATE SHEET

(54) 発明の名称: 裏面研削用粘着シート及び半導体ウエハの製造方法、基材シート

図1



(57) Abstract: Provided is an adhesive sheet for backgrinding that can increase the conformance of a substrate layer to protruding sections of a semiconductor wafer. The present invention provides an adhesive sheet for backgrinding of a semiconductor wafer that has protruding sections, said adhesive sheet comprising a substrate layer and an adhesive agent layer that is provided on the substrate layer. The adhesive agent layer has an opening with a smaller diameter than the diameter of the semiconductor wafer, is adhered to an outer circumference section of the semiconductor wafer such that the protruding sections of the semiconductor wafer are positioned within the opening, and is configured such that, while the semiconductor wafer is adhered to the adhesive agent layer, the protruding sections are protected by the substrate layer. The substrate layer comprises a cushion layer and a barrier layer, and the oxygen permeability of the substrate layer as measured on the basis of JIS K 7162-2 (isopiestic method) at 25°C and 0% RH is 1000 ml/m²·24h·atm) or less.

[続葉有]



WO 2022/249889 A1

SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 半導体ウエハの凸部への基材層の追従性を高めることができる、裏面研削用粘着シートを提供する。本発明によれば、凸部を有する半導体ウエハの裏面研削用粘着シートであって、基材層と、前記基材層上に設けられた粘着剤層と、を備え、前記粘着剤層は、前記半導体ウエハの直径よりも小径の開口部を有し、前記半導体ウエハの凸部が前記開口部内に配置されるように前記半導体ウエハの外周部に貼着され、前記半導体ウエハが前記粘着剤層に貼着された状態で前記凸部が前記基材層によって保護されるように構成され、前記基材層は、クッション層とバリア層を備え、前記基材層は、 25°C RH 0%における J I S K 7 1 6 2 - 2 (等圧法)に基づいて測定した酸素透過度が $1000\text{ml}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot \text{atm})$ 以下である、粘着シートが提供される。